

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН)



Организационно – правовая форма: Институт является федеральным государственным бюджетным учреждением науки, подведомственным ФАНО России.

Год создания: 1983 (постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 29 мая 1983г. и постановление Президиума АН СССР от 29 сентября 1983 г. № 1067).

Основные направления деятельности ИПТМ РАН (Утверждены Постановлением Президиума РАН от 12 февраля 2008г. № 34):

- физико-химические основы перспективных технологий создания элементной базы нано- и микроэлектроники, а также наносистемной и микросистемной техники;
- физические основы перспективных методов диагностики структур нано- и микроэлектроники, разработка диагностической аппаратуры;
- физические основы рентгеновской оптики и методов управления рентгеновским лучом, разработка методов рентгеновской и электронной литографии и микроскопии;
- исследование электрических, магнитных и оптических свойств нанометровых и квантоворазмерных структур с целью поиска новых физических принципов построения элементной базы нано- и микроэлектроники, а также нано- и микросистемной техники;
- исследование и разработка физико-химических методов получения и анализа высокочистых и функциональных материалов нано- и микроэлектроники.

Сведения о руководителе: Рощупкин Дмитрий Валентинович, ВРИО директора ИПТМ РАН, д.ф.-м.н.

Почтовый адрес Института: Российская Федерация, 142432, Московская область, город Черноголовка, ул.Академика Осипьяна, д. 6.

Контактные телефоны: Тел: (49652)4-40-58, факс: (495)962-80-47,

Сайт Института: www.iptm.ru

Адрес электронной почты: general@iptm.ac.ru